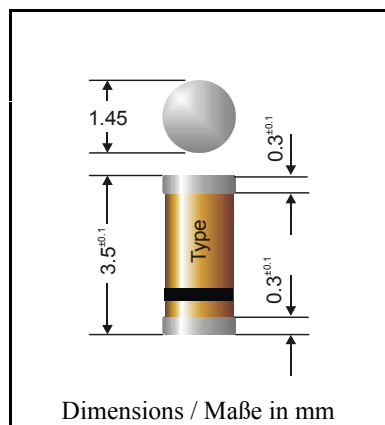


Surface Mount Si-Schottky Barrier Diodes

Silizium-Schottky-Dioden für die Oberflächenmontage



Nominal current Nennstrom	15 mA
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	40...60 V
Glass case MiniMELF Glasgehäuse MiniMELF	SOD 80 DO-213AA
Weight approx. – Gewicht ca.	0.05 g
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Period. Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Forward voltage Durchlaßspannung V_F [V] / $I_F = 1$ mA	V_F [V] / $I_F = 15$ mA
LL 101C	40	< 0.39	< 0.9
LL 101B	50	< 0.4	< 0.95
LL 101A	60	< 0.41	< 1

Power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	400 mW ¹⁾	
Peak forward surge current, 10 μs squarewave Stoßstrom für einen 10 μs Rechteckimpuls	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$	I_{FSM}	2 A	
Leakage current, $T_j = 25^{\circ}\text{C}$ Sperrstrom	LL101C	$V_R = 30\text{ V}$	I_R	< 200 nA
	LL101B	$V_R = 40\text{ V}$	I_R	< 200 nA
	LL101A	$V_R = 50\text{ V}$	I_R	< 200 nA
Junction capacitance Sperrschichtkapazität	$V_R = 0\text{ V}$	$f = 1\text{ MHz}$	C_{tot}	< 2.2 pF
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 5\text{ mA}$ through/über $I_R = 5\text{ A}$ to/auf $I_R = 0.5\text{ mA}$	t_{rr}	typ. 1 ns	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	+200°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	- 55...+200°C	
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	< 300 K/W ¹⁾	

¹⁾ Valid provided that terminals are kept at ambient temperature
Gültig wenn Anschlüsse auf Umgebungstemperatur gehalten werden